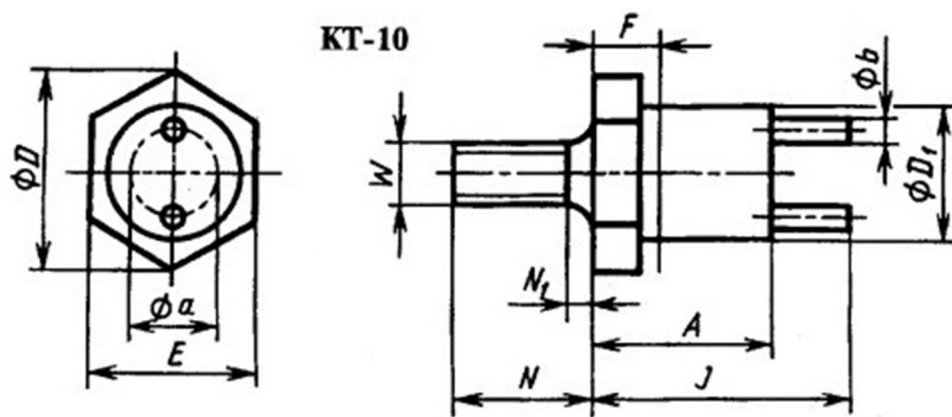


Транзистор КТ926А (2Т926А)

Транзисторы 2Т926А кремниевые мезапланарные структуры n-p-n импульсные.
 Предназначены для применения в импульсных модуляторах.
 Корпус (КТ-10) металлокерамический с жесткими выводами.



Обозначение размера	КТ-10		
	Не менее	Номин.	Не более
<i>A</i>	13,10	—	17,70
<i>a</i>	8,80	—	9,20
<i>b</i>	—	—	2,00
<i>D</i>	18,60	—	19,60
<i>D₁</i>	14,00	—	15,00
<i>E</i>	16,76	17,00	17,04
<i>F</i>	—	—	4,00
<i>J</i>	20,00	—	24,00
<i>N</i>	11,50	—	12,50
<i>N₁</i>	—	—	2,00
<i>W</i>	—	М6	—

Основные технические характеристики транзистора 2Т926А:

Структура транзистора: n-p-n;

$P_{к т max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 50 Вт;

$f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим

эмиттером: более 51 МГц;

$U_{кэг\ max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 150 В (0,1кОм);

$U_{эбо\ max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;

$I_{к\ max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 15 А;

$I_{к\ и\ max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 25 А;

$I_{кэг}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: не более 25 мА (150В);

$h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 10... 60;

$R_{кэ\ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0.17 Ом